DOI: 10.3969/J.ISSN.1000-5137.2021.06.003

BiFeO₃掺杂 Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃陶瓷的制备与磁电性能研究

熊 能¹,方梦珠¹,潘裕柏²,孙大志^{1*}

(1.上海师范大学化学与材料科学学院,上海200234;2.上海师范大学数理学院,上海200234)

摘 要: 以固相合成法制备了铁酸铋(BiFeO₃,简称BFO)掺杂的铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅 (Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃,简称PIN-PMN-PT)多铁性陶瓷材料,X射线衍射 (XRD)测试结果表明:样品具有钙钛矿结构,电滞回线显示其铁电性良好,剩余极化值(P_r)可 达 18 μ C·cm⁻².由于BiFeO₃掺杂后,样品电矩减小,氧空位增多,使其铁电畴翻转困难,样品的 电性能略有下降,但是其磁性能随BiFeO₃掺入量的增加而逐渐增强,且样品居里温度(T_m)为 200 ℃左右.该材料在电磁学领域有望成为具有应用前景的多铁性材料.

关键词:多铁性; 铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅(PIN-PMN-PT); 陶瓷

中图分类号: TQ 174.75 文献标志码: A 文章编号: 1000-5137(2021)06-0672-07

Preparation of BiFeO₃ doped Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃ ceramics and investigation on their electric and magnetic property

XIONG Neng¹, FANG Mengzhu¹, PAN Yubo², SUN Dazhi^{1*}

(1.College of Chemistry and Materials Science, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China;2.College of Mathematics and Science, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract: The multiferroic composite ceramic bismuth ferrite (BiFeO₃) doped lead niobate indium-lead magnesium niobate-lead titanate (Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃) which had a perovskite structure as the X-ray diffraction (XRD) showed was prepared by a solid-state synthesis. The hysteresis loop shows that its ferroelectricity performs well and the remanent polarization (P_r) reaches 18 μ C·cm⁻². Due to the doping of BiFeO₃, the electrical moment of the sample decreases, oxygen

收稿日期: 2021-05-27

基金项目: 国家重点研发计划(2016YFB0701004)

作者简介: 熊 能(1996—),男,硕士研究生,主要从事铁电陶瓷和磁电耦合材料方面的研究.E-mail: 502305200@qq.com

*通信作者:孙大志(1965一),男,教授,主要从事铁电、压电、多铁性功能材料、闪烁材料和稀土发光材料方面的研究.E-mail: sundazhi@shnu.edu.cn

引用格式:熊能,方梦珠,潘裕柏,等.BiFeO₃掺杂Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃陶瓷的制备与磁电性能研究[J].上海师范大学学报(自然科学版),2021,50(6):672-678.

Citation format: XIONG N, FANG M Z, PAN Y B, et al. Preparation of BiFeO₃ doped Pb $(In_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ -Pb $(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ -PbTiO₃ ceramics and investigation on their electric and magnetic property [J]. Journal of Shanghai Normal University (Natural Sciences), 2021, 50(6):672-678.

vacancies increase, and ferroelectric domain switching is difficult, resulting in a decrease in ferroelectric properties, but its magnetic properties gradually increase with the increase of BiFeO₃ doping. In addition, the sample has a Curie temperature (T_m) of about 200 °C, and it is expected to become a multiferroic material with promising applications in the field of electromagnetics. **Key words:** magnetoelectric; Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃(PIN-PMN-PT); ceramic

0 引 言

多铁性材料是一种同时具有铁电、铁磁和铁弹中两种或两种以上性能的材料.作为一种新型多功能 材料,多铁性材料的应用不再局限于单一铁性领域,更在新型磁-电传感器件、滤波器及"电写磁读"信 息存储器等领域展现出巨大的应用前景^[14].另一方面,多铁性材料涉及电荷、自旋、晶格等多个物理学 范畴,受到广大科研工作者的青睐.在多铁性材料大家庭中,磁电耦合材料的地位更是举足轻重.

由于磁性能和电性能两者共存困难,现有的单相磁电耦合材料较少,研究较多的有铁酸铋(BiFeO₃, 简称 BFO)和锰酸铽(TbMnO₃)^[5].其中 BiFeO₃是为数不多的居里温度(T_{m})高于室温的单相磁电耦合材料 之一, T_{m} 高达830 °C,奈尔温度为367 °C.但是 BiFeO₃合成困难,易产生杂相,且漏泄电流较大.为完善其 性能,研究者多采用掺杂的方法,如掺钛离子(Ti⁴⁺)和锆离子(Zr⁴⁺)以降低氧空位浓度^[6-8],掺镓(Ga)调控 其磁转变温度^[9],掺杂镧离子(La³⁺)同时提高其磁性能和电性能^[10].1972年,VAN SUCHTELEN^[11]便提出 复合材料的磁电耦合效应,即将具有铁电和铁磁性能的材料复合,形成一种新的多相磁电耦合材料.

目前看来,性能最好的铁电材料当属弛豫型铁电体铌镁酸铅(PMNT)体系,其中铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)铁电单晶压电常数*d*₃₃可超过2000 pC·N⁻¹,机电耦合系数(*k*_p)大于0.9^[12].在此基础上,三元系 统铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅(PIN-PMN-PT)具有更好的温度稳定性和更大的矫顽场(*E*_c)^[13],相比于 PMN-PT,铟(In)的加入可将其*T*_m由150℃左右提高至200℃左右,*E*_c由2.8 kV·cm⁻¹提高到5.5 kV·cm^{-1[14-15]}. 相比于铁电单晶,陶瓷材料工艺简单,成本较低,应用更加广泛.WANG等^[16]选取 PIN 摩尔分数分别为 0.36和0.46的三元系统 PIN-PMN-PT,通过调控 PMN 和 PT 的物质的量之比,制备出性能优异的 PIN-PMN-PT 陶瓷,其中样品组分为 0.36PIN-0.30PMN-0.34PT(系数表示摩尔分数)时,压电常数*d*₃₃达450 pC·N⁻¹,*T*_m为245℃,*k*_v为0.49,剩余极化值(*P*_v)和*E*_c分别为31.6 μC·cm⁻²和9.8 kV·cm⁻¹.

本文作者选取BiFeO₃提供磁性能,PIN-PMN-PT提供电性能,以期研制出一种新型磁电耦合陶瓷材料.由于组分在准同型相界(MPB)附近,材料性能较好,因此所选的组分为(0.24PIN-0.42PMN-0.34PT)-*x*BFO(*x*=0,0.01,0.03,0.05)(掺杂量*x*为摩尔分数),其PIN-PMN-PT组分处于MPB附近,如图1所示.



1 实验部分

1.1 药品及部分仪器设备

实验所用药品均为分析纯,主要包括氧化铟(In_2O_3)、氧化镁(MgO)、五氧化二铌(Nb_2O_5)、二氧化钛 (TiO_2)、四氧化三铅(Pb_3O_4)、氧化铁(Fe_2O_3)和氧化铋(Bi_2O_3),另使用无水乙醇作为溶剂,聚乙烯醇 (PVA)为黏结剂.

样品制作时所用仪器主要为:FA2004电子天平(上海良平仪器有限公司);ND6-1L行星球磨机(南京南大天尊电子有限公司);DHG-9023A恒温干燥箱(上海华连医疗器械有限公司);PC-24压片机(品 创科技有限公司);DF-101S恒温磁力搅拌器(上海予英仪器有限公司);KSL-1700X高温电炉(合肥科晶 材料技术有限公司);MPD-1单盘金相磨抛机(上海阜力测量设备有限公司);SK3200H超声波清洗器(上海科导超声仪器有限公司).

1.2 实验方法

采用传统高温固相法制备(0.24Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-0.42Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.34PbTiO₃)-*x*BFO(*x*=0,0.01, 0.03,0.05)陶瓷样品,尽管两步法合成钙钛矿结构Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})-PbTiO₃(PMNT)能抑制杂相的生成,但 其工艺流程繁琐,实验耗时较长,故本实验采取一步法合成,具体流程如下.

1) 配料:按照实验配比准确称取相应质量的氧化物,其中Pb₃O₄和Bi₂O₃在高温下易挥发,均过量3%.

2) 球磨:将配好的原料与适量酒精混合,放入行星球磨机中球磨12h,球磨机转速为120 r·min⁻¹.

3) 压大片: 球磨结束后干燥, 将干燥后的粉体压成直径40 mm的原片.

4)预烧:将压好的原片置于马弗炉中预烧2h,预烧温度为850℃,升温速率为3℃·min⁻¹.

5) 二次球磨:将预烧的块体研碎,球磨10 h.

6) 过筛:球磨干燥后取尺寸均匀的颗粒.

7) 压片:将上述粉体与约5%(质量分数)的PVA溶液混合均匀,压制成直径15 mm、厚度1~2 mm的小圆片.

8) 排塑:将成型的样品置于600 ℃下排塑2h.

9) 烧结:烧结温度为1200℃,时间2h,升温速率为5℃·min⁻¹.

10) 披银:将烧结好的样品打磨光滑,涂上银浆,以供测试使用.

1.3 实验测试方法及仪器

使用德国 BRUKER/AXS 公司生产的 D8 ADVANCE X-射线衍射仪(XRD)和日本厂家 Hitachi 生产的 S-4800 型号的扫描电子显微镜(FE-SEM),分别对样品的物相和形貌进行测试;德国 aixACCT 公司生产的 TF Analyzer 2000 FE-Module 铁电分析仪和美国 Lakeshore 7400 型振动样品磁强计则被用来测试陶 瓷样品的电性能和磁性能;使用美国 Keysight 公司的 E4990A 型阻抗分析仪,搭配温控系统,测试材料的 介电常数-温度及频率的相互关系.

2 结果与讨论

2.1 XRD 物相分析

1 200 ℃烧结 BFO 掺杂 0.24PIN-0.42PMN-0.34PT 陶瓷样品 XRD 图谱, 如图 2 所示. 由图 2 可知, 样品 为典型的钙钛矿结构, 峰型尖锐, 样品结晶性良好. 在 2*θ*=45°附近, (002)衍射峰劈裂为(002)和(200) 2 个峰, 说明样品同时含有三方相和四方相, 形成了两相共存的 MPB. 另外, BFO 掺杂量为 3% 和 5% 时,

XRD图谱在2*θ*=29°和2*θ*=35°处,各显现出一个微弱的杂峰,这是由于粉体在高温烧结下,Pb和Bi易挥发,不可避免地形成了焦绿石相.



图 2 [0.24PIN-0.42PMN-0.34PT]-xBFO 陶瓷 XRD 图

2.2 微观形貌

使用固相烧结法,即气孔率降低,粉体逐渐致密化的过程.物质的结构决定其性能,其烧结温度和时间等因素直接决定了样品晶粒尺寸的分布情况.图3为BFO掺杂0.24PIN-0.42PMN-0.34PT陶瓷样品的微观形貌图.从图3可以看出,样品晶粒尺寸较为均匀,掺入BFO之后,致密度逐渐增大,说明掺杂BFO有助于0.24PIN-0.42PMN-0.34PT陶瓷的烧结.随着BFO的掺杂,样品的晶粒尺寸略有下降,未掺杂时晶粒直径为25 µm左右;掺杂1%和3%的BFO后下降为23 µm左右;当掺杂量达到5%时,晶粒直径约为20 µm.究其原因,晶粒尺寸的下降应与晶界处的杂质有关,随着BFO的掺入,样品晶界处出现少许小颗粒,且随着掺杂量的增加而增加,小颗粒的出现或许有利于不均匀成核,但其同时增加了晶界能,从而抑制了晶粒的长大.



图 3 [0.24PIN-0.42PMN-0.34PT]-xBFO 陶瓷 FE-SEM 形貌图.(a) x=0;(b) x=0.01;(c) x=0.03;(d) x=0.05

2021年

2.3 铁电性能分析

BFO掺杂 0.24PIN-0.42PMN-0.34PT 陶瓷样品电极化随电场强度变化的曲线图,如图4所示,经过实验,样品电滞回线在测试场强为 35 kV·cm⁻¹时趋于饱和.掺杂量由少至多,样品的*P*_r(曲线与纵轴交点)分别为 18,13,13 和 11 μC·cm⁻², *E*_e(曲线与横轴交点)分别为 15.6,15.3,15.5 和 17.7 kV·cm⁻¹.纵向看来,样品的最大极化值和*P*_r皆随 BFO 掺杂量的增加而下降,说明 BFO 的掺入使样品中电偶极子电矩减小,致使总的极化量降低.另外,在烧结过程中,Pb和Bi易挥发,形成氧空位和游离电荷,增加了漏导电流,增大了极化难度,铁电畴转向困难,而且此现象随着 BFO 掺入量的增加而愈加严重,掺杂量为 5% 样品的*E*_e突然增至 17.7 kV·cm⁻¹,便是有力的证明.



2.4 磁性能分析

除却铁电性能,磁性能为磁电耦合材料的另一大特征.图5为BFO掺杂0.24PIN-0.42PMN-0.34PT 陶瓷样品磁极化随磁场变化的曲线图.由图5可以看出,与铁电性能相比,样品的磁性能虽未能展现出 完美的磁滞回线,却表现出一定的弱磁性,而且其磁性强度与BFO掺杂量的大小呈正相关,说明通过掺 杂BFO提高0.24PIN-0.42PMN-0.34PT陶瓷磁性能的方法可行性较高.



图5 [0.24PIN-0.42PMN-0.34PT]-xBFO陶瓷磁极化随磁场变化曲线

2.5 介电性能分析

*T*_m为铁电相与顺电相的转变温度,是铁电体一项极其重要的指标.一般情况下,铁电设备的工作温度应在*T*_m的一半以下,因此,提高铁电体的*T*_m显得尤为重要.选取未掺杂和掺杂3%BFO的0.24PIN-0.42PMN-0.34PT陶瓷样品,在不同频率下测试其介电常数随温度的变化,如图6所示.

图6为典型的弛豫型铁电体的介温图谱:1)介电常数最大值(*ε*_)并不是一个尖锐的峰,而是具有一



图6 不同频率下[0.24PIN-0.42PMN-0.34PT]-xBFO陶瓷介电常数随温度变化图

定温度区间的宽峰,即弛豫型铁电体铁电-顺电相的转变不是发生在一个温度点,而是在一个温度区间 内;2) ε_m随频率的升高而降低.ε_m对应的温度即为*T*_m,在本实验中,未掺杂时,PIN-PMN-PT陶瓷的*T*_m为 202 ℃左右;掺杂3% BFO后,*T*_m略有下降,为198 ℃.不容忽视的是,掺入BFO后,样品的介电常数大大降 低.以测试频率为10°Hz为例,最大介电常数由13 077下降为5 905,这是BFO引入较多杂质缺陷导 致的.

3 结 论

使用高温固相法在1200℃下煅烧制备出了BFO掺杂0.24PIN-0.42PMN-0.34PT的块状陶瓷,样品为三方相与四方相共存的钙钛矿结构,结晶性良好,晶粒尺寸在20~25µm之间,掺入BFO后样品晶粒尺寸略有下降,同时其致密度也提高了.所有陶瓷样品均可测出饱和的电滞回线,未掺杂时,样品的P,达18µC·cm⁻²,掺杂BFO后略有下降,这是因为BFO的掺入降低了电偶极子的电矩,使总的极化量降低;同时,BFO引入了较多氧空位等缺陷,铁电畴翻转困难,使掺杂量为5%时,样品E。突增至17.7 kV·cm⁻¹.此外,通过对介电-温度图谱分析得出样品的T_为200℃左右,满足大部分磁电设备对材料工作温度的需求.尽管0.24PIN-0.42PMN-0.34PT陶瓷掺杂BFO牺牲了其一部分电性能,但其磁性能随着BFO掺杂量的增加而不断增强,受限于工艺条件,样品各项性能未能达到较高的水准,但是BFO掺杂0.24PIN-0.42PMN-0.34PT陶瓷实现了磁电共存,这为磁电耦合材料的探究提供了一个全新的方案.

参考文献:

- PETRES J J, APACHITEI G, BBENLAND R, et al. Polarization curling and flux closures in multiferroic tunnel junctions
 [J]. Nature Communication, 2016, 7:13484.
- [2] 南策文.多铁性材料研究进展及发展方向[J].中国科学:技术科学,2015,45(4):339-357.
 NAN C W. The research progress and development direction of multiferroic material [J]. Scientia Sinica Techologica, 2015,45(4):339-357.
- [3] PALNEEDI H, ANNAPUREDDY V, PRYIA S, et al. Status and perspectives of multiferroic magnetoelectric composite materials and applications [J]. Actuators, 2016, 5(1):9–39.
- [4] EERENSTEIN W, MATHUR N D, SCOTT J F. Multiferroic and magnetoelectric materials [J]. Nature, 2006, 442

(7104):759-765.

- [5] KIMURA T, SHINTANI H, ISHIZAKA K, et al. Magnetic control of ferroelectric polarization [J]. Nature, 2003, 426 (6962):55-58.
- [6] DAI H Y, GU L T, XIE X Y, et al. The structure, defects, electrical and magnetic properties of BiFe_{1-x}Zr_xO₃ multiferroic ceramics [J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018(3):2275-2281.
- [7] KADER S M A, RUTH D E J, BABU M V G, et al. Investigations on the effect of Ba and Zr co-doping on the structural, thermal, electrical and magnetic properties of BiFeO₃ multiferroics [J]. Ceramics International, 2017, 43(17): 15544– 15550.
- [8] IVANOV M S, KHOMCHENKO V A, SILIBIN M V, et al. Investigation of local conduction mechanisms in Ca and Tidoped BiFeO₃ using scanning probe microscopy approach [J]. Nanomaterials, 2020, 10(5):940.
- [9] SINGH V, BRAJESH K, SAHU S, et al. Control of electrical leakage in magneto-electric gallium ferrite via aliovalent substitution [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2019, 102(12):7414-7427.
- [10] LIN Y H, JIANG Q H, WANG Y, et al. Enhancement of ferromagnetic properties in BiFeO₃ polycrystalline ceramic by La doping [J]. Applied Physics Letters, 2007, 90(17):172507.
- [11] VAN SUCHTELEN J. Product properties: a new application of composite materials [J]. Philips Research Repoort, 1972, 27(1):28-37.
- [12] 唐华,龙勇,李金,等. 铌镁酸铅系弛豫铁电单晶材料的发展与应用 [J]. 压电与声光,2021,43(3):406-412.
 TANG H, LONG Y, LI J, et al. The development and application of relaxor-PMNT single crystals [J]. Piezoelectrics and Acoustooptics, 2021, 43(3):406-412.
- [13] WANG Y K, FANG B J, LU X L, et al. Effects of nano-sized In₂O₃ on sintering behavior and electrical properties of 0.28Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O₃-0.40Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.32PbTiO₃ ceramics [J]. Integrated Ferroelectrics, 2020, 211(1):1-17.
- [14] ZHANG S J, LI F. High performance ferroelectric relaxor-PbTiO₃ single crystals: status and perspective [J]. Journal of Applied Physics, 2012, 111(3): 31301.
- [15] HOSONO Y, YAMASHITA Y, SAKAMOTO H, et al. Large Piezoelectric constant of high-curie-temperature Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})
 O₃-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})-PbTiO₃ ternary single crystal near morphotropic phase boundary [J]. Journal of Applied Physics, 2002, 41(11A):1240-1242.
- [16] WANG D W, CAO M S, ZHANG S J. Phase diagram and properties of Pb (In_{1/2}Nb_{1/2}) O₃-Pb (Mg_{1/3}Nb_{2/3}) O₃-PbTiO₃ polycrystalline ceramics [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2012, 32(2):433-439.

(责任编辑:郁慧,顾浩然)